

Физика и техника полупроводников, 2023, том 57, выпуск 8

Международная конференция Физика.СПб, 23-27 октября 2023 г., Санкт-Петербург [-1mm]

Леньшин А.С., Пешков Я.А., Черноусова О.В., Барков К.А., Канныкин С.В.

Влияние режимов травления на морфологию и состав поверхности многослойного пористого кремния

613

Гуляева И.А., Петров В.В.

Моделирование солнечного элемента на основе пленок Co_3O_4 $(\text{Co}_3\text{O}_4)_{1-x}(\text{ZnO})_x$

617

Власов А.С., Афанасьев К.М., Галимов А.И., Калюжный Н.А., Лебедев Д.В., Малевская А.В., Минтаиров С.А., Рахлин М.В., Салий Р.А., Можаров А.М., Мухин И.С., Минтаиров А.М.

Пространственно-селективная эпитаксия квантовых точек InP/GaInP₂ металлоорганических соединений

620

Кононов А.А., Ильинский А.В., Кастро Р.А., Климов В.А., Пашкевич М.Э., Попова И.О., Шадрин Е.Б.

Особенности фазового перехода в тонких пленках суперионного полупроводника AgI

624

Ивлев К.Е., Болотов В.В., Пономарева И.В., Князев Е.В.

Формирование канального кремния для создания фильтрующих слоев

628

Гавриков А.А., Кузнецов В.Г., Колобов А.В.

Варизонность 2D слоев CdTe в фазе сфалерита и в фазе с граничными атомами халькогена

632

Козловский А.В., Чуфарова Н.А., Байбикова Д.Р., Сердобинцев А.А., Стецюра С.В.

Влияние соотношения компонентов в гетерогенном материале CdS-PbS на его фотоэлектрические характеристики и их стабильность во времени

636

Ружеви́ч М.С., Мынбаев К.Д., Баженов Н.Л., Варавин В.С., Ремесник В.Г., Михайлов Н.Н., Якушев М.В.

Фотолюминесценция эпитаксиальных слоев $\text{Hg}_{0.3}\text{Cd}_{0.7}\text{Te}$ и $\text{Hg}_{0.7}\text{Cd}_{0.3}\text{Te}$

640

Соболев М.М., Солдатенков Ф.Ю.

Дефекты с глубокими уровнями в высоковольтных плавных p-i-n-гетеропереходах AlGaAsSb/GaAs

644

Публикация материалов Конференции завершена

Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Калмыков А.Е., Мясоедов А.В., Сорокин Л.М.

Дислокационная структура темплейтов AlN/SiC , выращенных методом сублимации

648

Пашенко А.С., Девицкий О.В., Лунина М.Л.

Дефекты в эпитаксиальных пленках GaInAsBi на подложках Si (001)

652

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Тихий А.А., Николаенко Ю.М., Свиридова Е.А., Жихарев И.В.

Оптические свойства и структура пленок оксида индия, полученных при различных условиях магнетронного распыления

658

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Адамов Р.Б., Мелентьев Г.А., Подоскин А.А., Кондратов М.И., Гришин А.Е., Слипченко С.О., Седова И.В., Сорокин С.В., Клишко Г.В., Махов И.С., Фирсов Д.А., Шалыгин В.А.

Люминесценция в p-i-n-структурах с компенсированными квантовыми ямами

663

Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Степанов Н.П.

Сближение энергий плазмона и электронного перехода в кристалле $\text{Bi}_{0.6}\text{Sb}_{1.4}\text{Te}_3$

674

Физика полупроводниковых приборов

Слипченко С.О., Подоскин А.А., Шушканов И.В., Крючков В.А., Ризаев А.Э., Кондратов М.И., Гришин А.Е., Пихтин Н.А., Багаев Т.А., Светогоров В.Н., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Симаков В.А.

Сильноточные низковольтные ключи для импульсов нс-длительности на основе тиристорных гомо- и гетероструктур $(\text{Al})\text{GaAs}/\text{GaAs}$

678

Соколова З.Н., Асрян Л.В.

Анализ устойчивости генерации в лазерах на квантовых ямах

684

Подоскин А.А., Шушканов И.В., Ризаев А.Э., Кондратов М.И., Гришин А.Е., Слипченко С.О.

Селекция латеральных мод микролинеек одномодовых лазерных диодов (1050 нм) во внешнем резонаторе

693

Минтаиров М.А., Евстропов В.В., Минтаиров С.А., Салий Р.А., Надточий А.М., Калюжный Н.А.

Влияние температуры на ток через различные рекомбинационные каналы в GaAs -солнечных элементах с GaInAs -квантовыми точками

700

Дубинов А.А., Ушаков Д.В., Афоненко А.А.

Оптические потери волновода со сверхпроводящими обкладками в терагерцовых квантово-каскадных лазерах

706

Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Пивоварова А.А., Ильинская Н.Д., Куницына Е.В., Яковлев Ю.П.

Разработка способа травления фотодиодных $\text{InAs}/\text{InAsSbP}$ -гетероструктур

710

